**Research Center for Photovoltaics** 

## p型結晶Si太陽電池における PIDのメカニズムの解明

城内 紗千子1•萩原 英昭2•佐藤 浩昭3•増田 淳1 産業技術総合研究所 1.太陽光発電研究センター 2.機能化学研究部門 3.環境管理研究部門

## 研究の目的

太陽光発電システムの出力が短期間で大幅に低下するPotential Induced Degradation (PID) 現象が報告されている. PIDは、モジュール内のセルとアルミフレームの間に大 きな電位差が発生することにより起こる現象であり、太陽電池モジュール表面の白板強**∢** 化ガラスからNaイオンが拡散し、封止材を介してセルの表面や内部に侵入することが 原因と考えられている[1,2]. PIDの防止方法として体積抵抗率の高い封止材を用いるこ とが知られている [3,4]が、体積抵抗率の高いionomerなどを用いればPIDは生じないも のの、PIDの主原因とされていたNaの拡散が検出される場合も報告されており[5]、Na はPID発現の十分条件ではないことが示唆される.本研究では、PID現象と漏れ電流、 さらにI-V特性の低下と封止材の体積抵抗率の関係について検討したので報告する。





台の封止材でもPIDを完全抑止できる。 *I-V*特性の低下と相関のある試験時の漏れ電流は、封止材の種類 だけでなくガラスと封止材の界面や封止材中の添加剤にも影響される。

[4] K. Hara et al.: RSC Adv., 5, 15017-15023 (2015).

関係者各位に深く感謝致します。

[5] A. Masuda et al.: Jpn. J. Appl. Phys., 55, 02BF10 (2016).

謝辞:本研究の成果はNEDOの委託のもと得られたものであり、